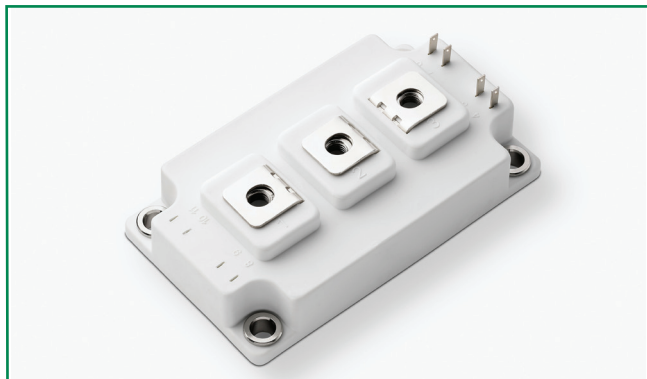



MG17100D-BN4MM



Agency Approvals

AGENCY	AGENCY FILE NUMBER
	E71639

Features

- IGBT³ CHIP(1700V Trench+Field Stop technology)
- Low turn-off losses, short tail current
- $V_{CE(sat)}$ with positive temperature coefficient
- DIODE CHIP(1700V EMCON 3 technology)
- Free wheeling diodes with fast and soft reverse recovery

Applications

- High frequency switching application
- Medical applications
- Motion/servo control
- UPS systems

Module Characteristics ($T_c = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)

Symbol	Parameters	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
$T_{J(max)}$	Max. Junction Temperature				150	$^\circ\text{C}$
$T_{J(op)}$	Operating Temperature		-40		125	$^\circ\text{C}$
T_{stg}	Storage Temperature		-40		125	$^\circ\text{C}$
V_{isol}	Insulation Test Voltage	AC, t=1min		4000		V
CTI	Comparative Tracking Index		350			
Torque	Module-to-Sink	Recommended (M6)	3		5	N·m
Torque	Module Electrodes	Recommended (M6)	2.5		5	N·m
Weight				320		g

Absolute Maximum Ratings ($T_c = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)

Symbol	Parameters	Test Conditions	Values	Unit
IGBT				
V_{CES}	Collector - Emitter Voltage	$T_J=25^\circ\text{C}$	1700	V
V_{GES}	Gate - Emitter Voltage		± 20	V
I_C	DC Collector Current	$T_c=25^\circ\text{C}$	150	A
		$T_c=80^\circ\text{C}$	100	A
I_{CM}	Repetitive Peak Collector Current	$t_p=1\text{ms}$	200	A
P_{tot}	Power Dissipation Per IGBT		690	W
Diode				
V_{RRM}	Repetitive Reverse Voltage	$T_J=25^\circ\text{C}$	1700	V
$I_{F(AV)}$	Average Forward Current	$T_c=25^\circ\text{C}$	150	A
		$T_c=80^\circ\text{C}$	100	A
I_{FRM}	Repetitive Peak Forward Current	$t_p=1\text{ms}$	200	A
I^2t		$T_J = 125^\circ\text{C}, t = 10\text{ms}, V_R = 0\text{V}$	1650	A^2S

Life Support Note:

Not Intended for Use in Life Support or Life Saving Applications

The products shown herein are not designed for use in life sustaining or life saving applications unless otherwise expressly indicated.

Electrical and Thermal Specifications ($T_c = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)

Symbol	Parameters	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
IGBT						
$V_{GE(th)}$	Gate - Emitter Threshold Voltage	$V_{CE}=V_{GE}, I_C=4.0\text{mA}$	5.2	5.8	6.4	V
$V_{CE(sat)}$	Collector - Emitter Saturation Voltage	$I_C=100\text{A}, V_{GE}=15\text{V}, T_J=25^\circ\text{C}$		2.0	2.45	V
		$I_C=100\text{A}, V_{GE}=15\text{V}, T_J=125^\circ\text{C}$		2.4		V
I_{CES}	Collector Leakage Current	$V_{CE}=1700\text{V}, V_{GE}=0\text{V}, T_J=25^\circ\text{C}$			3	mA
		$V_{CE}=1700\text{V}, V_{GE}=0\text{V}, T_J=125^\circ\text{C}$			20	mA
I_{GES}	Gate Leakage Current	$V_{CE}=0\text{V}, V_{GE}=\pm 20\text{V}, T_J=125^\circ\text{C}$	-400		400	nA
R_{Gint}	Intergrated Gate Resistor			4.8		Ω
Q_{ge}	Gate Charge	$V_{CE}=900\text{V}, I_C=100\text{A}, V_{GE}=\pm 15\text{V}$		1.2		μC
C_{ies}	Input Capacitance	$V_{CE}=25\text{V}, V_{GE}=0\text{V}, f=1\text{MHz}$		9		nF
C_{res}	Reverse Transfer Capacitance				0.3	
$t_{d(on)}$	Turn - on Delay Time	$V_{CC}=900\text{V}$ $I_C=100\text{A}$ $R_G=4\Omega$ $V_{GE}=\pm 15\text{V}$ Inductive Load	$T_J=25^\circ\text{C}$		370	ns
			$T_J=125^\circ\text{C}$		400	ns
t_r	Rise Time		$T_J=25^\circ\text{C}$		40	ns
			$T_J=125^\circ\text{C}$		50	ns
$t_{d(off)}$	Turn - off Delay Time		$T_J=25^\circ\text{C}$		650	ns
			$T_J=125^\circ\text{C}$		800	ns
t_f	Fall Time		$T_J=25^\circ\text{C}$		180	ns
			$T_J=125^\circ\text{C}$		300	ns
E_{on}	Turn - on Energy		$T_J=25^\circ\text{C}$		22	mJ
			$T_J=125^\circ\text{C}$		32	mJ
E_{off}	Turn - off Energy	$T_J=25^\circ\text{C}$		21	mJ	
		$T_J=125^\circ\text{C}$		31	mJ	
I_{SC}	Short Circuit Current	$t_{psc}\leq 10\mu\text{S}, V_{GE}=15\text{V}, T_J=125^\circ\text{C}, V_{CC}=1000\text{V}$		400		A
R_{thJC}	Junction-to-Case Thermal Resistance (Per IGBT)				0.18	K/W
Diode						
V_F	Forward Voltage	$I_F=100\text{A}, V_{GE}=0\text{V}, T_J=25^\circ\text{C}$		1.8	2.2	V
		$I_F=100\text{A}, V_{GE}=0\text{V}, T_J=125^\circ\text{C}$		1.9		V
I_{RRM}	Max. Reverse Recovery Current	$I_F=100\text{A}, V_R=900\text{V}$		160		A
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge	$di_f/dt=-2400\text{A}/\mu\text{s}$		48		μC
E_{rec}	Reverse Recovery Energy	$T_J=125^\circ\text{C}$		27		mJ
R_{thJCD}	Junction-to-Case Thermal Resistance (Per Diode)				0.26	K/W

Figure 1: Typical Output Characteristics

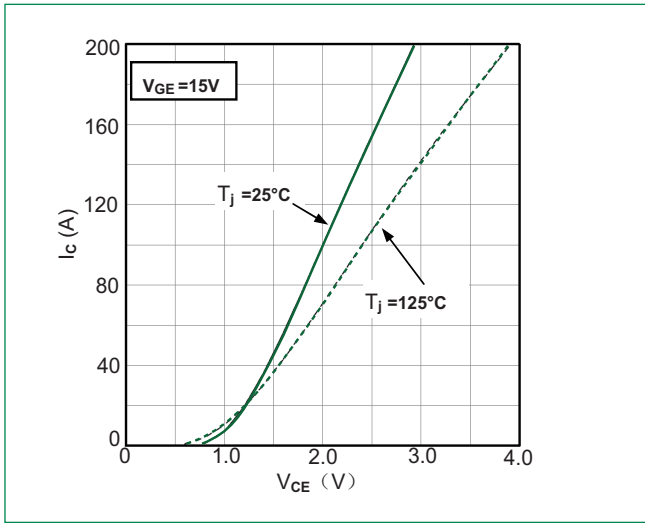


Figure 2: Typical Output Characteristics

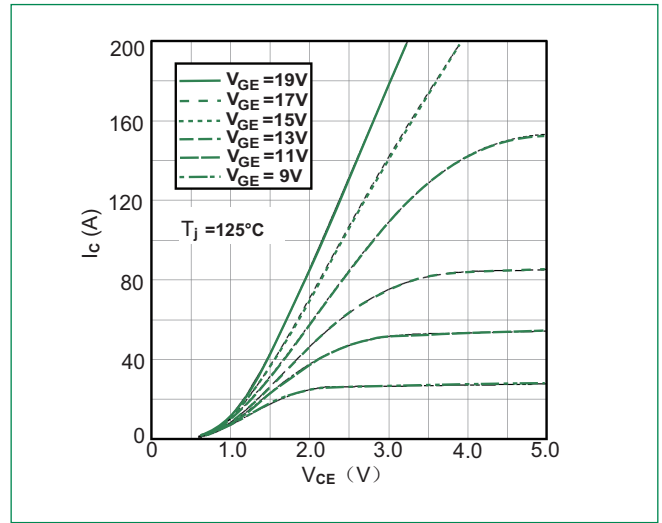


Figure 3: Typical Transfer characteristics

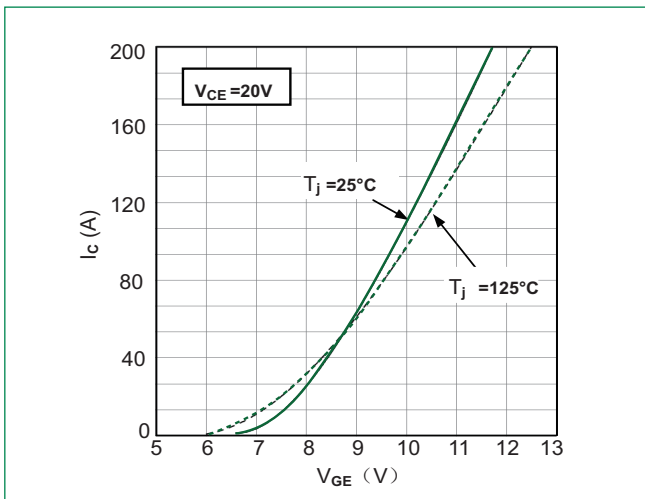


Figure 4: Switching Energy vs. Gate Resistor

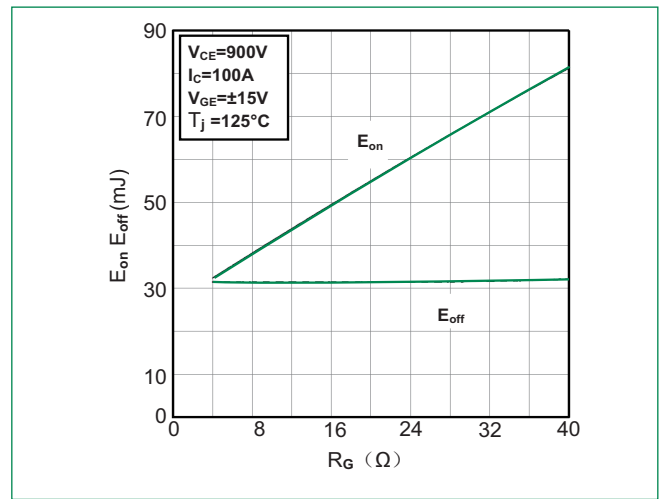


Figure 5: Switching Energy vs. Collector Current

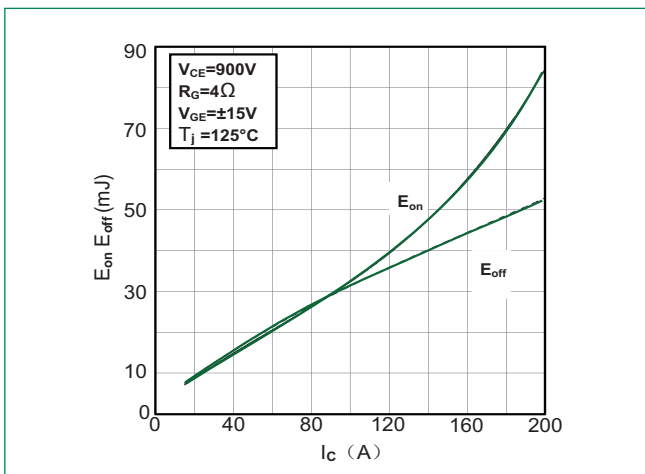


Figure 6: Reverse Biased Safe Operating Area

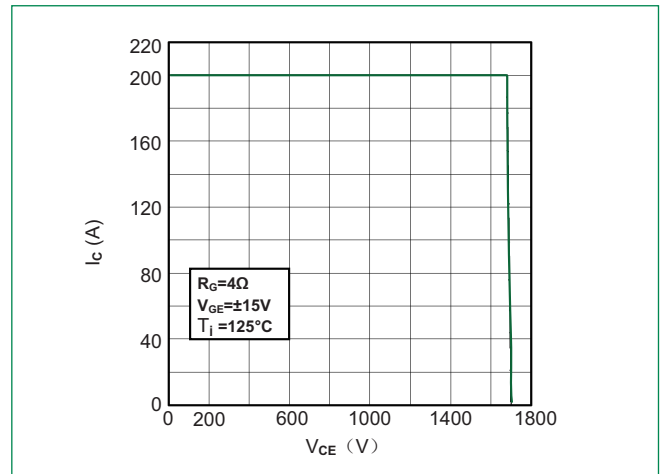


Figure 7: Diode Forward Characteristics

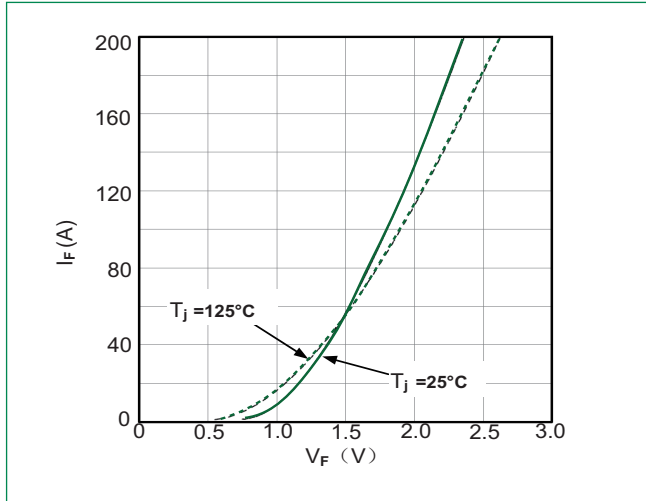


Figure 8: Switching Energy vs. Gate Resistor

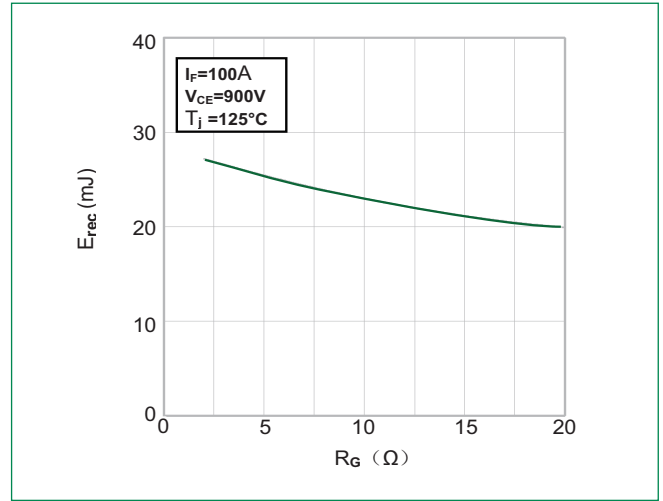


Figure 9: Switching Energy vs. Forward Current

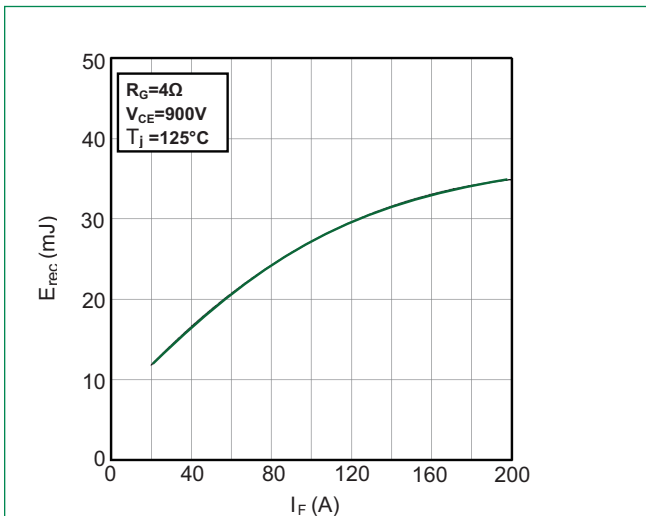
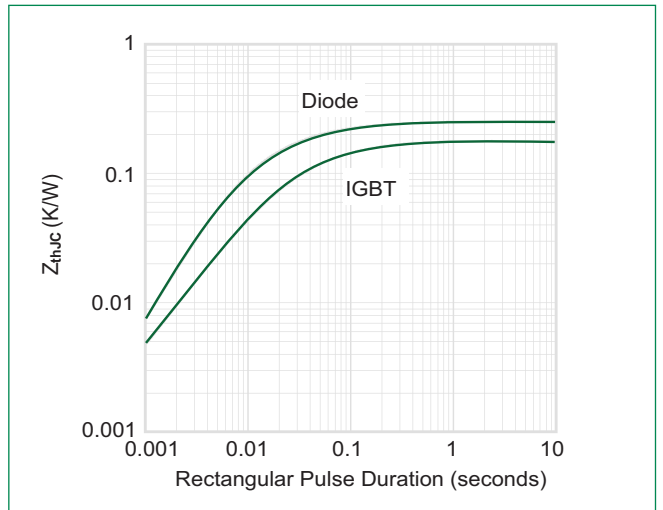
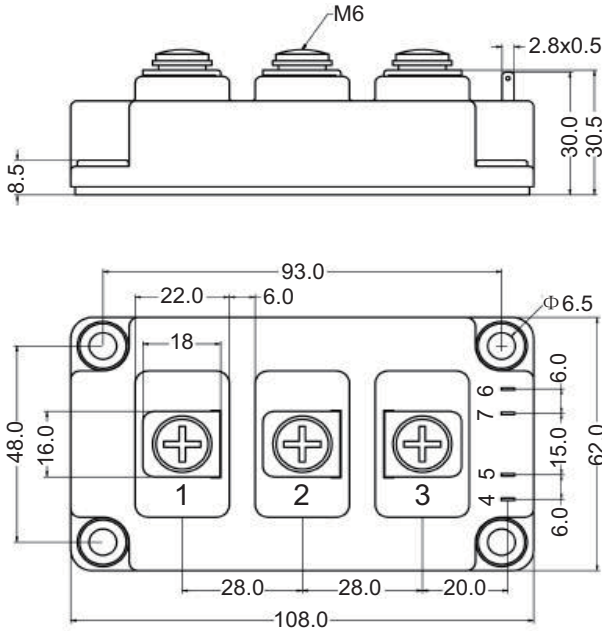


Figure 10: Transient Thermal Impedance of Diode and IGBT

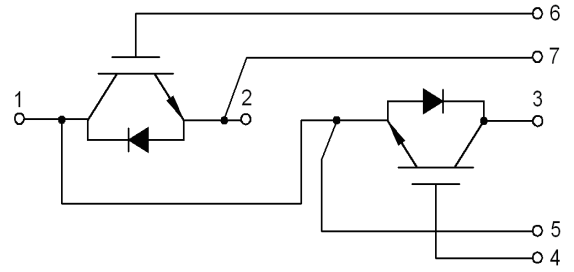


Dimensions-Package D



Dimensions in mm

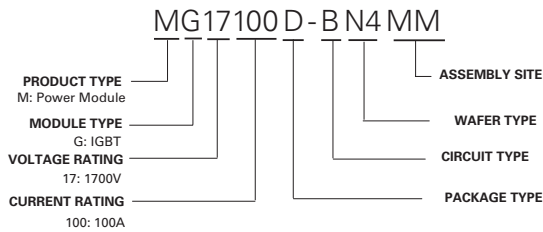
Circuit Diagram



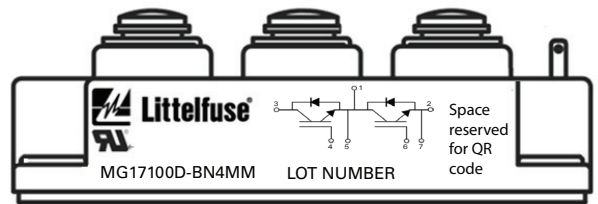
Packing Options

Part Number	Marking	Weight	Packing Mode	M.O.Q
MG17100D-BN4MM	MG17100D-BN4MM	320g	Bulk Pack	30

Part Numbering System



Part Marking System





Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331